

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 6 部門第 2 区分  
 【発行日】平成26年12月25日 (2014.12.25)

【公開番号】特開2013-109160(P2013-109160A)  
 【公開日】平成25年6月6日 (2013.6.6)  
 【年通号数】公開・登録公報2013-028  
 【出願番号】特願2011-254245(P2011-254245)  
 【国際特許分類】

G 0 9 G 3/34 (2006.01)

G 0 9 G 3/20 (2006.01)

G 0 2 F 1/167 (2006.01)

【 F I 】

G 0 9 G 3/34 C

G 0 9 G 3/20 6 3 1 M

G 0 9 G 3/20 6 3 1 D

G 0 9 G 3/20 6 2 1 F

G 0 9 G 3/20 6 3 1 R

G 0 2 F 1/167

【手続補正書】

【提出日】平成26年11月5日 (2014.11.5)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

所定の期間を単位とする a 回の電圧印加により光学状態が第 1 状態から第 2 状態に変化する複数の電気光学素子に対応する複数の画素の各々について、現在の階調値を記憶する第 1 メモリー、次に表示される階調値を記憶する第 2 メモリー、および電圧印加の残回数に応じたカウンター値を記憶した第 3 メモリーへのアクセスを制御するメモリー制御手段と、

温度を示す温度情報を取得する取得手段と、

前記取得手段により取得された温度情報により示される温度がしきい値以下であった場合において、前記複数の画素のうち処理対象となる対象画素について階調の書き換えを開始するときは、前記対象画素について、前記第 3 メモリーに記憶されているカウンター値として  $b$  ( $b < a$ ) を、前記メモリー制御手段を介して書き込む残回数設定手段と、

前記対象画素について、前記第 3 メモリーに記憶されているカウンター値により示される残回数がゼロでない場合、前記対象画素への電圧印加を行わせる制御をする駆動制御手段と、

前記所定の期間が経過した場合において、 $a$  個の前記所定の期間の中から  $b$  個の前記所定の期間を選択するための条件が満たされたときは、前記第 3 メモリーに記憶されているカウンター値を、前記メモリー制御手段を介してデクリメントする残回数更新手段と

を有する制御装置。

【請求項 2】

温度と電圧印加回数との組を複数含むテーブルを記憶した記憶手段を有し、

$a$  は、前記テーブルに含まれる電圧印加回数の最大値である

ことを特徴とする請求項 1 に記載の制御装置。

**【請求項 3】**

前記取得手段により取得された温度に応じて、前記条件を決定する決定手段を有することを特徴とする請求項 1 または 2 の制御装置。

**【請求項 4】**

請求項 1 ないし 3 のいずれか一項に記載の制御装置と、  
前記複数の電気光学素子と  
を有する電気光学装置。

**【請求項 5】**

請求項 4 に記載の電気光学装置を有する電子機器。

**【請求項 6】**

所定の期間を単位とする  $a$  回の電圧印加により光学状態が第 1 状態から第 2 状態に変化する複数の電気光学素子と、制御装置と、前記複数の電気光学素子に対応する複数の画素の各々について、現在の階調値を記憶する第 1 メモリー、次に表示される階調値を記憶する第 2 メモリー、および電圧印加の残回数に応じたカウンタ値を記憶した第 3 メモリーへのアクセスを制御するメモリー制御手段を有する電気光学装置の制御方法であって、  
前記制御装置が、温度を示す温度情報を取得するステップと、

前記取得された温度情報により示される温度がしきい値以下であった場合において、前記複数の画素のうち処理対象となる対象画素について階調の書き換えを開始するときは、前記対象画素について、前記第 3 メモリーに記憶されているカウンタ値として  $b$  ( $b < a$ ) を、前記メモリー制御手段を介して書き込むステップと、

前記対象画素について、前記第 3 メモリーに記憶されているカウンタ値により示される残回数がゼロでない場合、前記対象画素への電圧印加を行わせる制御をするステップと、

前記所定の期間が経過した場合において、 $a$  個の前記所定の期間の中から  $b$  個の前記所定の期間を選択するための条件が満たされたときは、前記第 3 メモリーに記憶されているカウンタ値を、前記メモリー制御手段を介してデクリメントするステップと  
を有する制御方法。

**【請求項 7】**

所定の期間を単位とする  $a$  回の電圧印加により光学状態が第 1 状態から第 2 状態に変化する複数の電気光学素子に対応する複数の画素の各々について、次に表示される階調値を記憶する第 2 メモリー、および電圧印加の残回数に応じたカウンタ値を記憶した第 3 メモリーへのアクセスを制御するメモリー制御手段と、

前記複数の画素のうち処理対象となる対象画素について階調の書き換えを開始するときは、前記対象画素について、前記第 3 メモリーに記憶されているカウンタ値として  $b$  ( $b < a$ ) を、前記メモリー制御手段を介して書き込む残回数設定手段と、

前記対象画素について、前記第 3 メモリーに記憶されているカウンタ値により示される残回数がゼロでない場合、前記対象画素への電圧印加を行わせる制御をする駆動制御手段と、

前記所定の期間が経過した場合において、 $a$  個の前記所定の期間の中から  $b$  個の前記所定の期間を選択するための条件が満たされたときは、前記第 3 メモリーに記憶されているカウンタ値を、前記メモリー制御手段を介してデクリメントする残回数更新手段と  
を有する制御装置。